



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HX3199

对应国外型号
KTC3199

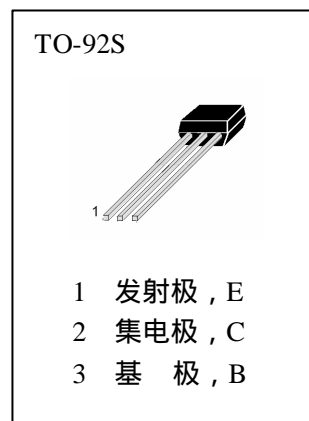
主要用途

小功率放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~125
T_j	——结温.....	125
P_C	——集电极耗散功率.....	200mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	50V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	50V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	5V
I_C	——集电极电流.....	150mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	50			V	$I_C=10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	50			V	$I_C=100\mu A, I_B=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{CB}=50V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	70		700		$V_{CE}=6V, I_C=2mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.1	0.25	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$
f_T	特征频率	80			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=1mA$
C_{ob}	共基极输出电容		2.0	3.5	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$
NF	噪声系数		1.0	10	dB	$V_{CE}=6V, I_C=0.1mA, f=1KHz, R_g=10K$

分档及其标志

O	Y	GR	BL
70—140	120—240	200—400	350—700